

CM1003-BGD 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护，适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

### ■ 功能特点

- 1) 高精度电压检测功能
  - 过充电保护电压 4.525 V 精度  $\pm 20$  mV
  - 过充电解除电压 4.325 V 精度  $\pm 45$  mV
  - 过放电保护电压 2.500 V 精度  $\pm 50$  mV
  - 过放电解除电压 2.900 V 精度  $\pm 100$  mV
  - 放电过流保护电压 0.130 V 精度  $\pm 5$  mV
  - 短路保护电压 0.500 V 精度  $\pm 40$  mV
  - 充电过流保护电压 -0.150 V 精度  $\pm 5$  mV
- 2) 内部检测延迟时间
  - 过充电保护延时 1.0 s 精度  $\pm 30\%$
  - 过放电保护延时 32 ms 精度  $\pm 30\%$
  - 放电过流保护延时 16 ms 精度  $\pm 30\%$
  - 充电过流保护延时 16 ms 精度  $\pm 30\%$
- 3) 充电器检测及负载检测功能
- 4) 可选择向 0V 电池充电功能 允许
- 5) 可选择休眠功能 无
- 6) 可选择放电过流状态的解除条件 断开负载
- 7) 可选择放电过流状态的解除电压  $V_{RIOV}$
- 8) 低电流消耗
  - 工作时 1.5  $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ\text{C}$ )
  - 过放电时 0.5  $\mu$ A (典型值) ( $T_a = +25^\circ\text{C}$ )
- 9) RoHS、无铅、无卤素

### ■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

### ■ 封装

- DFN1.9 $\times$ 1.6-6L

■ 系统功能框图

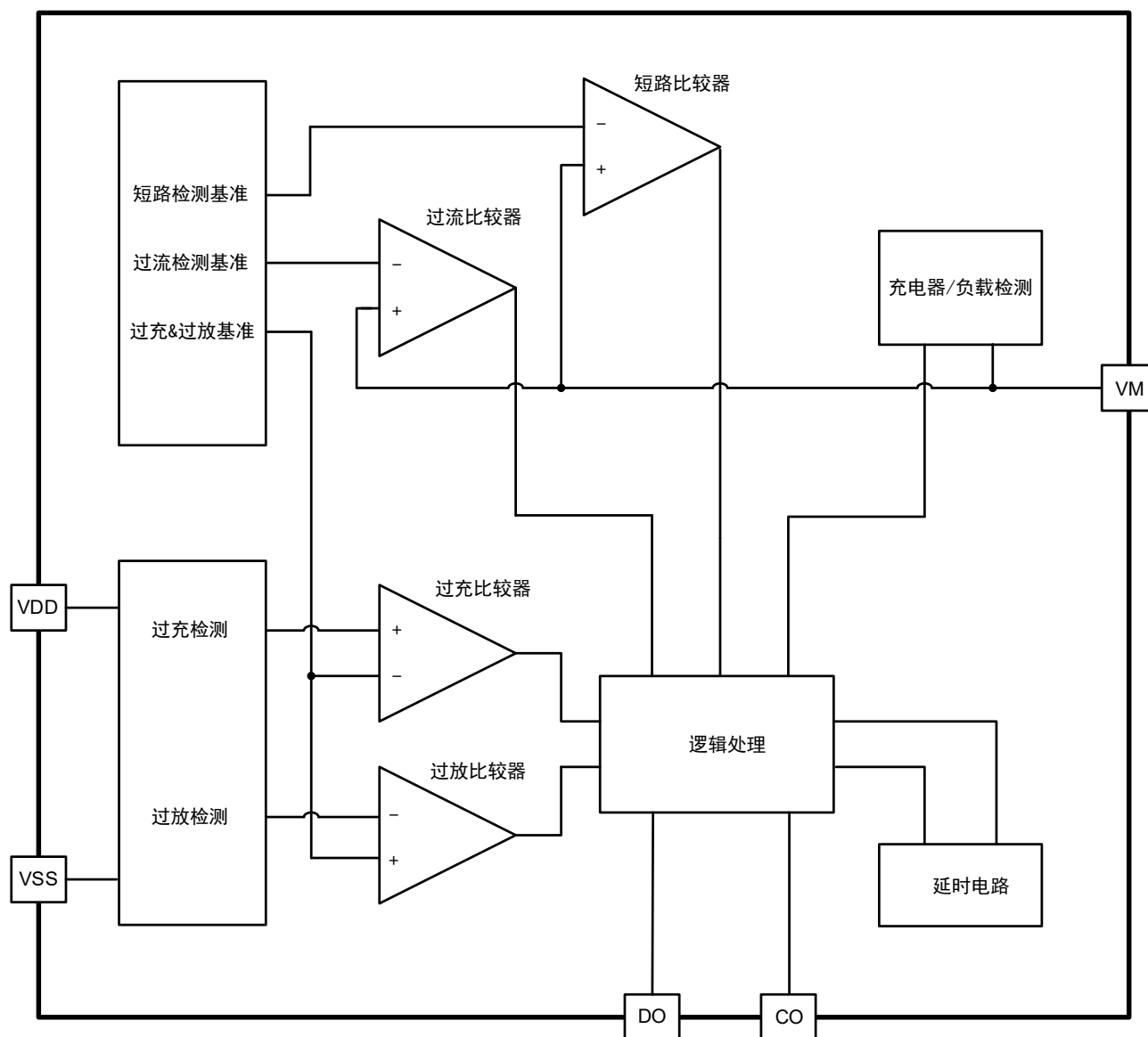
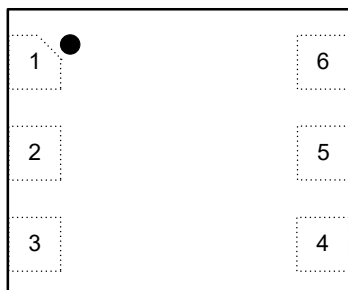
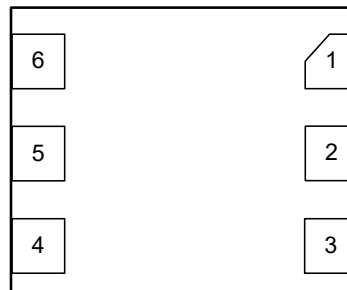


图 1

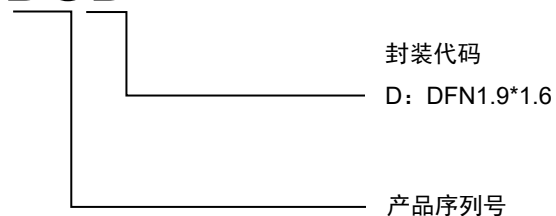
**■ 引脚排列图**
**DFN1.9×1.6-6L**

**图 2 顶视图**

**图 3 底视图**

引脚号	符号	描述
1	NC	无连接
2	CO	充电 MOSFET 控制端子
3	DO	放电 MOSFET 控制端子
4	VSS	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
5	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
6	VM	充放电电流检测端子，与充电器或负载的负极连接

**表 1**

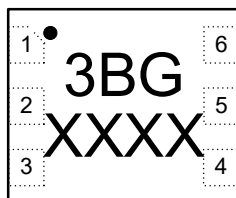
■ 命名规则

CM1003-BGD



■ 印字说明

DFN1.9×1.6-6L



第一行：3 为产品系列代码，BG 为产品序列号  
第二行：生产批次

图 4

**■ 产品列表**
**DFN1.9×1.6-6L 封装产品**
**1. 检测电压表**

产品名称	过充电 保护电压 $V_{OC}$	过充电 解除电压 $V_{OCR}$	过放电 保护电压 $V_{OD}$	过放电 解除电压 $V_{ODR}$	放电过流 保护电压 $V_{EC}$	短路 保护电压 $V_{SHORT}$	充电过流 保护电压 $V_{CHA}$
CM1003-BGD	4.525 V	4.325 V	2.500 V	2.900 V	0.130 V	0.500 V	-0.150 V

**表 2**
**2. 产品功能表**

产品名称	向 0V 电池 充电功能	放电过流状态 解除条件	放电过流状态 解除电压	过充自恢复 功能	休眠功能	延迟时间 代码
CM1003-BGD	允许	断开负载	$V_{RIOV}$	有	无	A

**表 3**
**3. 延迟时间代码**

延迟时间代码	过充电保护延时 $T_{OC}$	过放电保护延时 $T_{OD}$	放电过流延时 $T_{EC}$	充电过流延时 $T_{CHA}$	短路延时 $T_{SHORT}$
A	1000 ms	32 ms	16 ms	16 ms	280 $\mu$ s

**表 4**

**■ 绝对最大额定值**

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V <sub>VM</sub>	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
CO 输出端子电压	V <sub>CO</sub>	V <sub>VM</sub> -0.3 ~ VDD+0.3	V
DO 输出端子电压	V <sub>DO</sub>	VSS-0.3 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	T <sub>OPR</sub>	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T <sub>STG</sub>	-55 ~ +125	°C

**表 5**
**注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。**

**■ 电气特性**

(除特殊注明以外: Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>[功耗]</b>						
正常工作电流	I <sub>OPe</sub>	VDD=3.5V, V <sub>VM</sub> =0V	0.9	1.5	3.0	μA
过放电流	I <sub>OPeD</sub>	VDD=V <sub>VM</sub> =1.5V	-	0.5	1.0	μA
<b>[检测电压]</b>						
过充电保护电压	V <sub>OC</sub>	VDD=3.5 → 4.8V	4.505	4.525	4.545	V
过充电解除电压	V <sub>OCr</sub>	VDD=4.8 → 3.5V	4.280	4.325	4.370	V
过放电保护电压	V <sub>OD</sub>	VDD=3.5 → 2.0V	2.450	2.500	2.550	V
过放电解除电压	V <sub>ODr</sub>	VDD=2.0 → 3.5V	2.800	2.900	3.000	V
放电过流保护电压	V <sub>EC</sub>	VM-VSS=0 → 0.30V	0.125	0.130	0.135	V
短路保护电压	V <sub>SHORT</sub>	VM-VSS=0 → 1.5V	0.460	0.500	0.540	V
充电过流保护电压	V <sub>CHA</sub>	VSS-VM=0 → 0.30V	-0.155	-0.150	-0.145	V
放电过流解除电压	V <sub>RIOV</sub>	-	VDD-1.4	VDD-1.0	VDD-0.6	V
<b>[延迟时间]</b>						
过充电保护延时	T <sub>OC</sub>	VDD=3.5 → 4.8V	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T <sub>OD</sub>	VDD=3.5 → 2.0V	22.4	32	41.6	ms
放电过流保护延时	T <sub>EC</sub>	VM-VSS=0 → V <sub>EC</sub> +0.1V	11.2	16	20.8	ms
充电过流保护延时	T <sub>CHA</sub>	VSS-VM=0 → 0.30V	11.2	16	20.8	ms
短路保护延时	T <sub>SHORT</sub>	VM-VSS=0 → 1.5V	140	280	504	μs
<b>[内部电阻]</b>						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R <sub>VMC</sub>	VDD=1.8V, V <sub>VM</sub> =0V	750	1500	3000	kΩ
VM 端子-VSS 端子间电阻	R <sub>VMS</sub>	VDD=3.5V, V <sub>VM</sub> =1.0V	10	20	30	kΩ
<b>[输出电阻]</b>						
CO 端子电阻 “H”	R <sub>COH</sub>	-	5	10	20	kΩ
CO 端子电阻 “L”	R <sub>COL</sub>	-	5	10	20	kΩ
DO 端子电阻 “H”	R <sub>DOH</sub>	-	5	10	20	kΩ
DO 端子电阻 “L”	R <sub>DOL</sub>	-	5	10	20	kΩ
<b>[向 0V 电池充电的功能]</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V <sub>0CH</sub>	允许向 0V 电池充电功能	0	0.7	1.5	V

**表 6**

**■ 电气特性**

(除特殊注明以外: Ta = -20°C ~ +60°C\*1)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>[功耗]</b>						
正常工作电流	I <sub>OPe</sub>	VDD=3.5V, V <sub>VM</sub> =0V	0.6	1.5	5.0	μA
过放电流	I <sub>OPeD</sub>	VDD=V <sub>VM</sub> =1.5V	-	0.5	1.5	μA
<b>[检测电压]</b>						
过充电保护电压	V <sub>OC</sub>	VDD=3.5 → 4.8V	4.485	4.525	4.565	V
过充电解除电压	V <sub>OCr</sub>	VDD=4.8 → 3.5V	4.250	4.325	4.400	V
过放电保护电压	V <sub>OD</sub>	VDD=3.5 → 2.0V	2.420	2.500	2.580	V
过放电解除电压	V <sub>ODr</sub>	VDD=2.0 → 3.5V	2.780	2.900	3.020	V
放电过流保护电压	V <sub>EC</sub>	VM-VSS=0 → 0.30V	0.120	0.130	0.140	V
短路保护电压	V <sub>SHORT</sub>	VM-VSS=0 → 1.5V	0.420	0.500	0.580	V
充电过流保护电压	V <sub>CHA</sub>	VSS-VM=0 → 0.30V	-0.160	-0.150	-0.140	V
放电过流解除电压	V <sub>RIOV</sub>	-	VDD-1.6	VDD-1.0	VDD-0.4	V
<b>[延迟时间]</b>						
过充电保护延时	T <sub>OC</sub>	VDD=3.5 → 4.8V	500	1000	2000	ms
过放电保护延时	T <sub>OD</sub>	VDD=3.5 → 2.0V	16	32	64	ms
放电过流保护延时	T <sub>EC</sub>	VM-VSS=0 → V <sub>EC</sub> +0.1V	8	16	32	ms
充电过流保护延时	T <sub>CHA</sub>	VSS-VM=0 → 0.30V	8	16	32	ms
短路保护延时	T <sub>SHORT</sub>	VM-VSS=0 → 1.5V	112	280	616	μs
<b>[内部电阻]</b>						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R <sub>VMC</sub>	VDD=1.8V, V <sub>VM</sub> =0V	500	1500	6000	kΩ
VM 端子-VSS 端子间电阻	R <sub>VMS</sub>	VDD=3.5V, V <sub>VM</sub> =1.0V	7.5	20	40	kΩ
<b>[输出电阻]</b>						
CO 端子电阻 “H”	R <sub>COH</sub>	-	2.5	10	30	kΩ
CO 端子电阻 “L”	R <sub>COL</sub>	-	2.5	10	30	kΩ
DO 端子电阻 “H”	R <sub>DOH</sub>	-	2.5	10	30	kΩ
DO 端子电阻 “L”	R <sub>DOL</sub>	-	2.5	10	30	kΩ
<b>[向 0V 电池充电的功能]</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V <sub>0CH</sub>	允许向 0V 电池充电功能	0	0.7	1.8	V

**表 7**

\*1.并没有在高温以及低温的条件下进行筛选, 因此只保证在此温度范围下的设计规格。



## ■ 功能描述

### 1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）以上并在过充电保护电压（ $V_{OC}$ ）以下，且VM端子电压在充电过流保护电压（ $V_{CHA}$ ）以上并在放电过流保护电压（ $V_{EC}$ ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

### 2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压（ $V_{OC}$ ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ $T_{OC}$ ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

- 1)  $VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压（ $V_{OCR}$ ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 移开充电器并连接负载（ $VM > V_{EC}$ ），当电池电压降低到过充电保护电压（ $V_{OC}$ ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

### 3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ $T_{OD}$ ）时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VDD端子与VM端子间的电压差降低到1.0V（典型值）以下，消耗电流将减少至过放时的消耗电流（ $I_{OPED}$ ），在过放电状态下，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V$ （典型值），当电池电压高于过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ （典型值） $< VM < 0.7V$ （典型值），当电池电压高于过放电解除电压（ $V_{ODR}$ ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ （典型值），当电池电压高于过放电解除电压（ $V_{ODR}$ ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

### 4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压（ $V_{EC}$ ），并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间（ $T_{EC}$ ），则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压（ $V_{SHORT}$ ），并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间（ $T_{SHORT}$ ），则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ $V_{RIOV}$ ”。

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间通过 $R_{VMS}$ 电阻来连接。在连接负载期间，VM端子由于负载连接而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 $V_{RIOV}$ 以下时，即可解除放电过流状态。

## 5. 充电过流状态

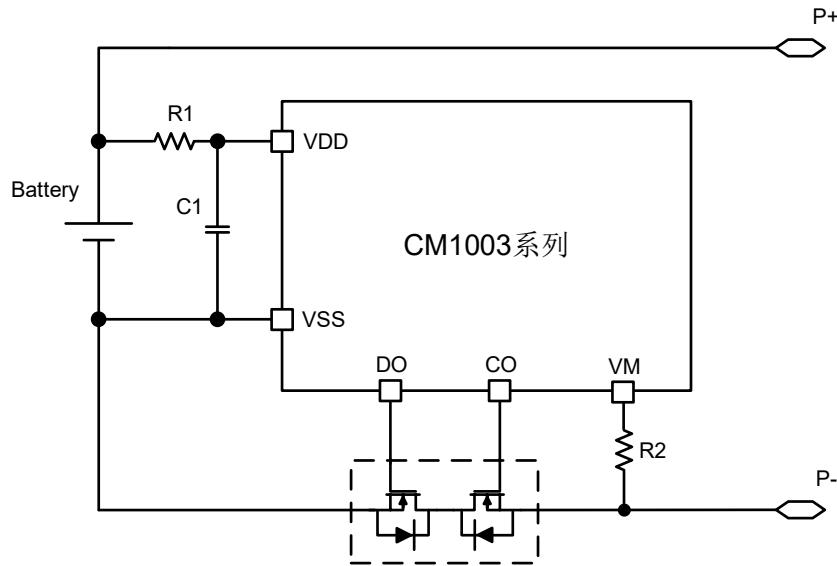
正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ $V_{CHA}$ ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ $T_{CHA}$ ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

**注意：**充电过流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由 $R_{VMC}$ 或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

## 6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“向0V电池充电的充电器起始电压（ $V_{0CH}$ ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ $V_{th}$ ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ $V_{OD}$ ）时，IC进入正常工作状态。

**注意：**请咨询电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

**■ 典型应用原理图**

**图 5**

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1500	$\Omega$
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	$\mu\text{F}$
R2	2	1 ~ 3	$\text{k}\Omega$

**表 8**
**注意：**

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

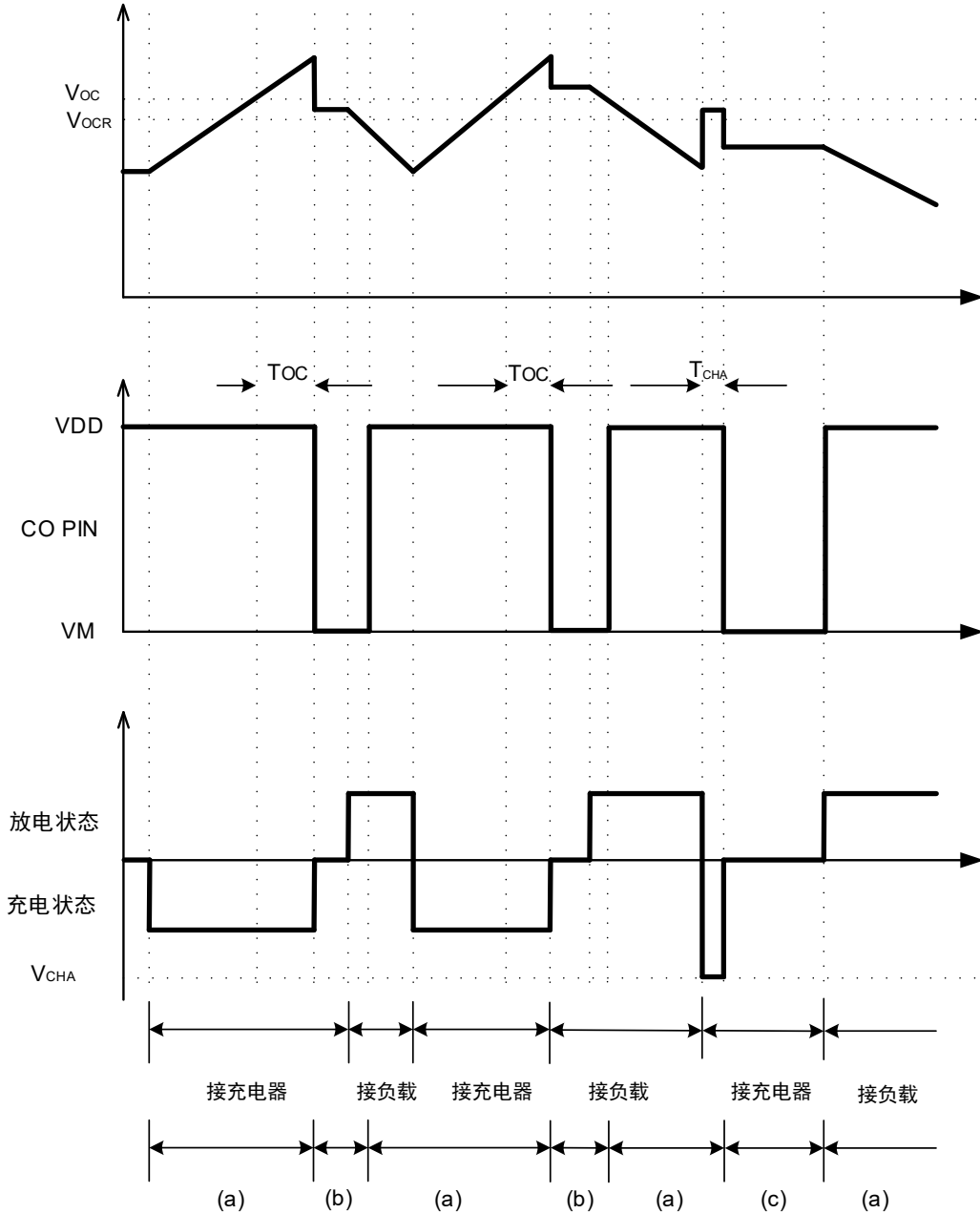


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

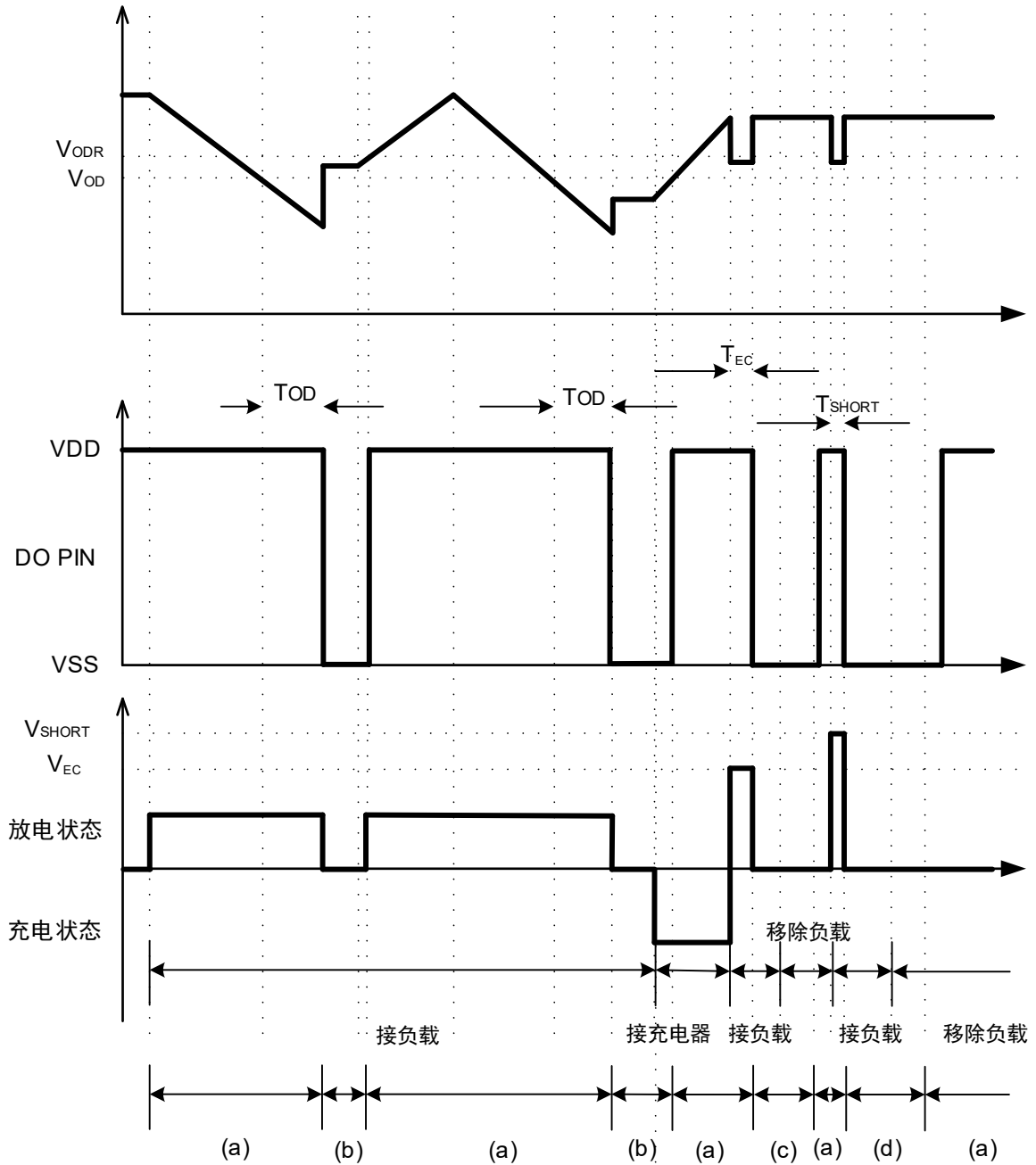


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

## ■ 测试电路

### 1. 过充电保护电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V_1$ 缓慢提升至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$  时的 $V_1$ 的电压即为过充电保护电压 ( $V_{OC}$ )。之后, 设置 $V_2=0.01V$ , 将 $V_1$ 缓慢下降至 $V_{CO} = "L" \rightarrow "H"$  时的 $V_1$ 的电压即为过充电解除电压 ( $V_{OCR}$ )。

### 2. 过放电保护电压、过放电解除电压（测试电路 2）

在 $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V_1$ 缓慢降低至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$  时的 $V_1$ 的电压即为过放电保护电压( $V_{OD}$ )。之后, 设置 $V_2=0.01V$ , 将 $V_1$ 缓慢提升至 $V_{DO} = "L" \rightarrow "H"$  时的 $V_1$ 的电压即为过放电解除电压 ( $V_{ODR}$ )。

### 3. 放电过电流保护电压、放电过电流解除电压（测试电路 2）

在 $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V_2$ 提升, 直至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$  为止, 此时的 $V_2$ 电压即为放电过电流检测电压 ( $V_{EC}$ )。

在放电过电流状态下, 设置 $V_2=3.5V$ , 将 $V_2$ 缓慢降低, 直至 $V_{DO} = "L" \rightarrow$  脉冲" $H$ " 时(此时放电过电流状态解除后, 可能由于 $V_2$ 电压高于 $V_{SHORT}$ 而发生负载短路保护再次使 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ )的 $V_2$ 电压即为放电过电流状态的解除电压 ( $V_{RIOV}$ )。

### 4. 负载短路保护电压（测试电路 2）

在 $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V_2$ 瞬间提升, 经过负载短路保护延迟时间 ( $T_{SHORT}$ )后立即发生 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ , 此时的 $V_2$ 的电压即为负载短路保护电压 ( $V_{SHORT}$ )。

### 5. 充电过流保护电压（测试电路 2）

在 $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V_2$ 降低, 直至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$  为止, 此时的 $V_2$ 电压即为充电过电流保护电压 ( $V_{CHA}$ )。

### 6. 工作时消耗电流（测试电路 3）

在  $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$  设置后的状态下, 流经  $V_{DD}$  端子的电流  $I_{CC}$  即为工作时消耗电流 ( $I_{OPE}$ )。

### 7. 过放电时消耗电流（测试电路 3）

在  $V_1=V_2=1.5V$  设置后的状态下, 流经  $V_{DD}$  端子的电流  $I_{CC}$  即为过放电时消耗电流 ( $I_{OPED}$ )。

### 8. VDD 端子-VM 端子间电阻（测试电路 3）

在  $V_1=1.8V$ ,  $V_2=0V$  设置后的状态下,  $V_{DD}$  端子- $VM$  端子间电阻即为  $R_{VMC}$ 。

### 9. VM 端子-VSS 端子间电阻（测试电路 3）

在  $V_1=3.5V$ ,  $V_2=1.0V$  设置后的状态下,  $VM$  端子-VSS 端子间电阻即为  $R_{VMS}$ 。

### 10. CO 端子电阻 “H”（测试电路 4）

在  $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ ,  $V_3=3.1V$  设置后的状态下,  $V_{DD}$  端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "H" ( $R_{COH}$ )。

### 11. CO 端子电阻 “L”（测试电路 4）

在  $V_1=4.7V$ ,  $V_2=0V$ ,  $V_3=0.4V$  设置后的状态下,  $VM$  端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "L" ( $R_{COL}$ )。

### 12. DO 端子电阻 “H”（测试电路 4）

在  $V_1=3.5V$ ,  $V_2=0V$ ,  $V_4=3.1V$  设置后的状态下,  $V_{DD}$  端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "H" ( $R_{DOH}$ )。

### 13. DO 端子电阻 “L”（测试电路 4）

在  $V_1=1.8V$ ,  $V_2=0V$ ,  $V_4=0.4V$  设置后的状态下,  $V_{SS}$  端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "L" ( $R_{DOL}$ )。

**14. 过充电保护延迟时间（测试电路 5）**

在 $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 提升, 从 $V1$ 超过 $V_{OC}$ 时开始到 $V_{CO} = "L"$  为止的时间即为过充电保护延迟时间 ( $T_{OC}$ )。

**15. 过放电保护延迟时间（测试电路 5）**

在 $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 降低, 从 $V1$ 低于 $V_{OD}$ 时开始到 $V_{DO} = "L"$  为止的时间即为过放电保护延迟时间 ( $T_{OD}$ )。

**16. 放电过流保护延迟时间（测试电路 5）**

在 $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 提升, 从 $V2$ 超过 $V_{EC}$ 时开始到 $V_{DO} = "L"$  为止的时间即为放电过流保护延迟时间 ( $T_{EC}$ )。

**17. 负载短路保护延迟时间（测试电路 5）**

在 $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 提升, 从 $V2$ 超过 $V_{SHORT}$ 时开始到 $V_{DO} = "L"$  为止的时间即为负载短路保护延迟时间 ( $T_{SHORT}$ )。

**18. 充电过流保护延迟时间（测试电路 5）**

在 $V1=3.5V$ ,  $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 降低, 从 $V2$ 低于 $V_{CHA}$ 时开始到 $V_{CO} = "L"$  为止的时间即为充电过流保护延迟时间 ( $T_{CHA}$ )。

**19. 开始向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电的功能)（测试电路 2）**

在 $V1=V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 缓慢降低, 当 $V_{CO} = "H"$  ( $V_{CO} = V_{DD}$ ) 时的 $V2$ 的电压的绝对值即为开始向0V电池充电的充电器电压( $V_{0CHA}$ )。

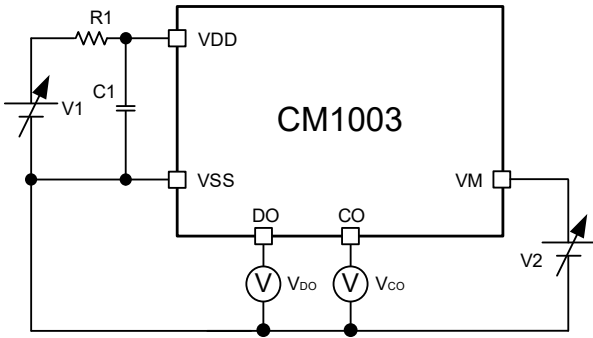


图 8 测试电路 1

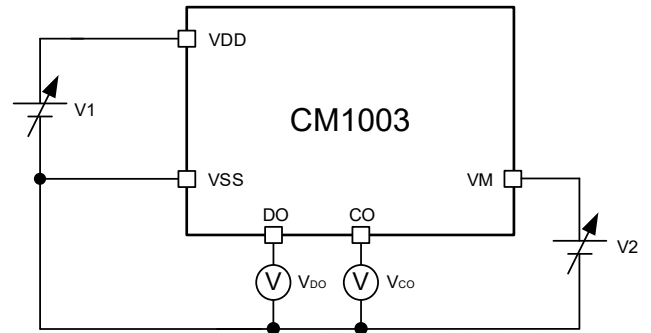


图 9 测试电路 2

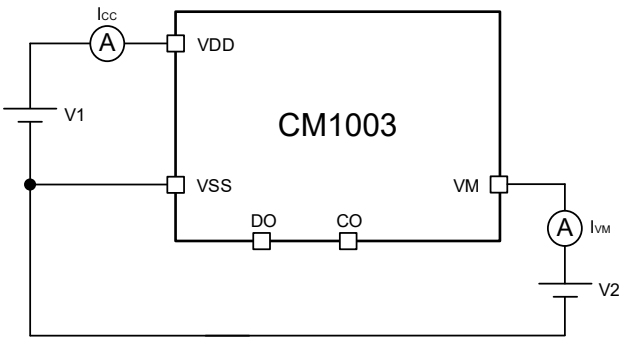


图 10 测试电路 3

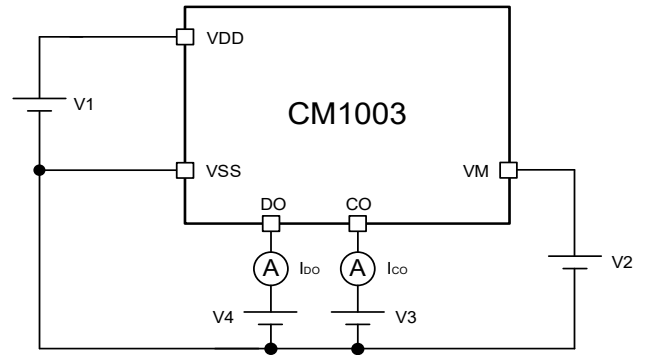


图 11 测试电路 4

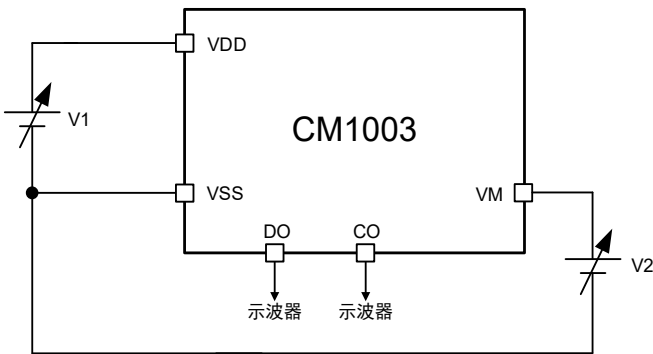
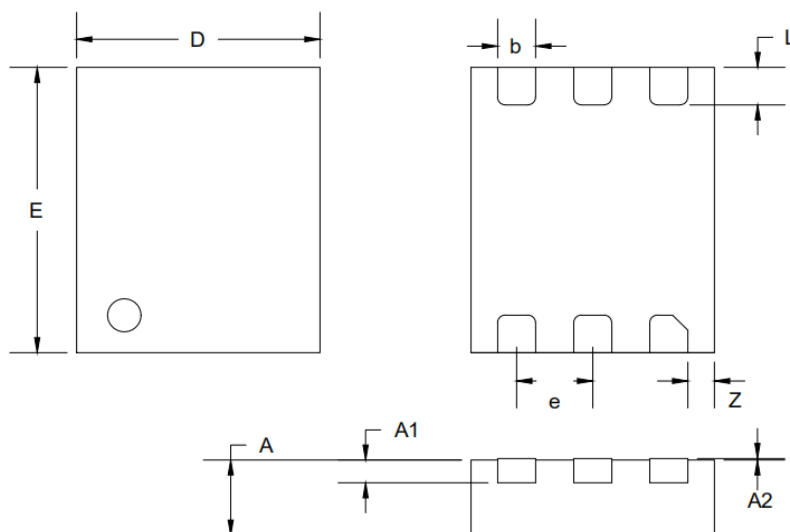


图 12 测试电路 5

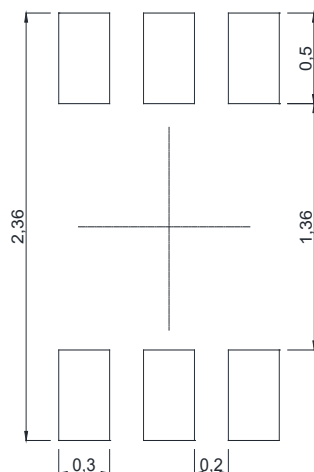


**■ 封装信息**
**DFN1.9×1.6-6L**

**图 13**

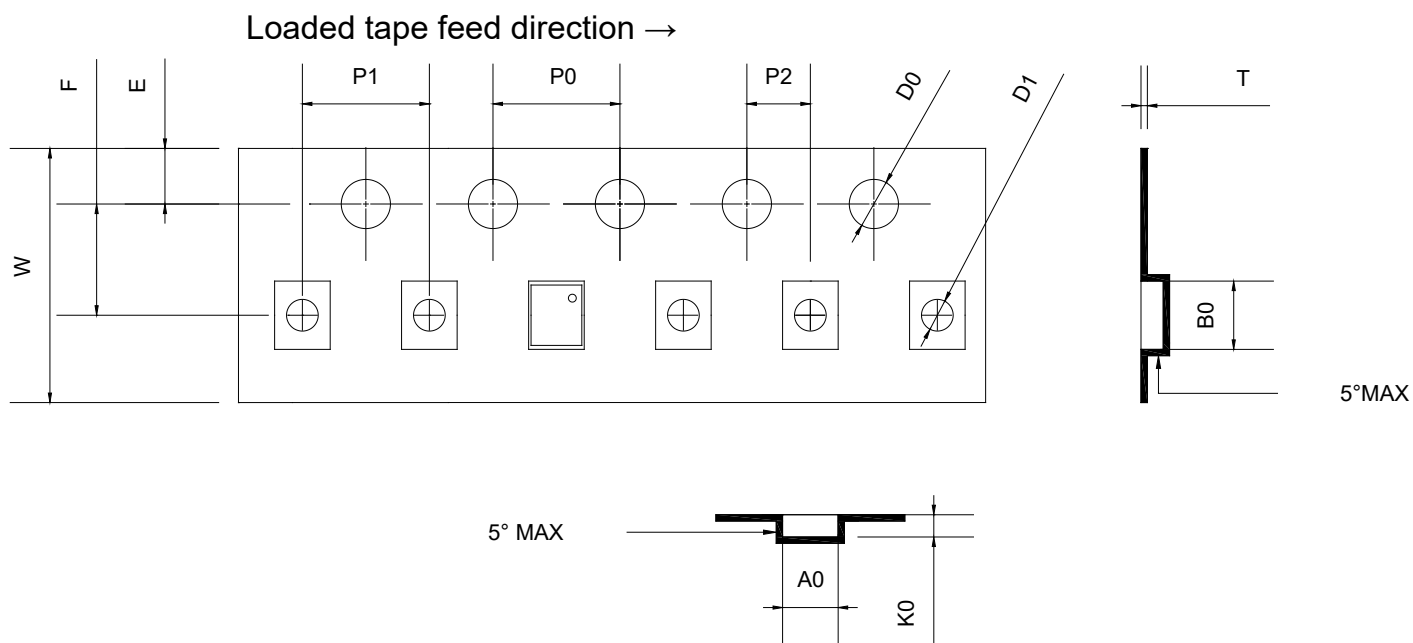
NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
D	1.550	1.600	1.650
E	1.850	1.900	1.950
L	0.200	0.250	0.300
b	0.200	0.250	0.300
Z	0.125	0.175	0.225
e	0.500BSC		
A	0.400	0.500	0.600
A1	0.15REF		
A2	0.000	-	0.050

**表 9**

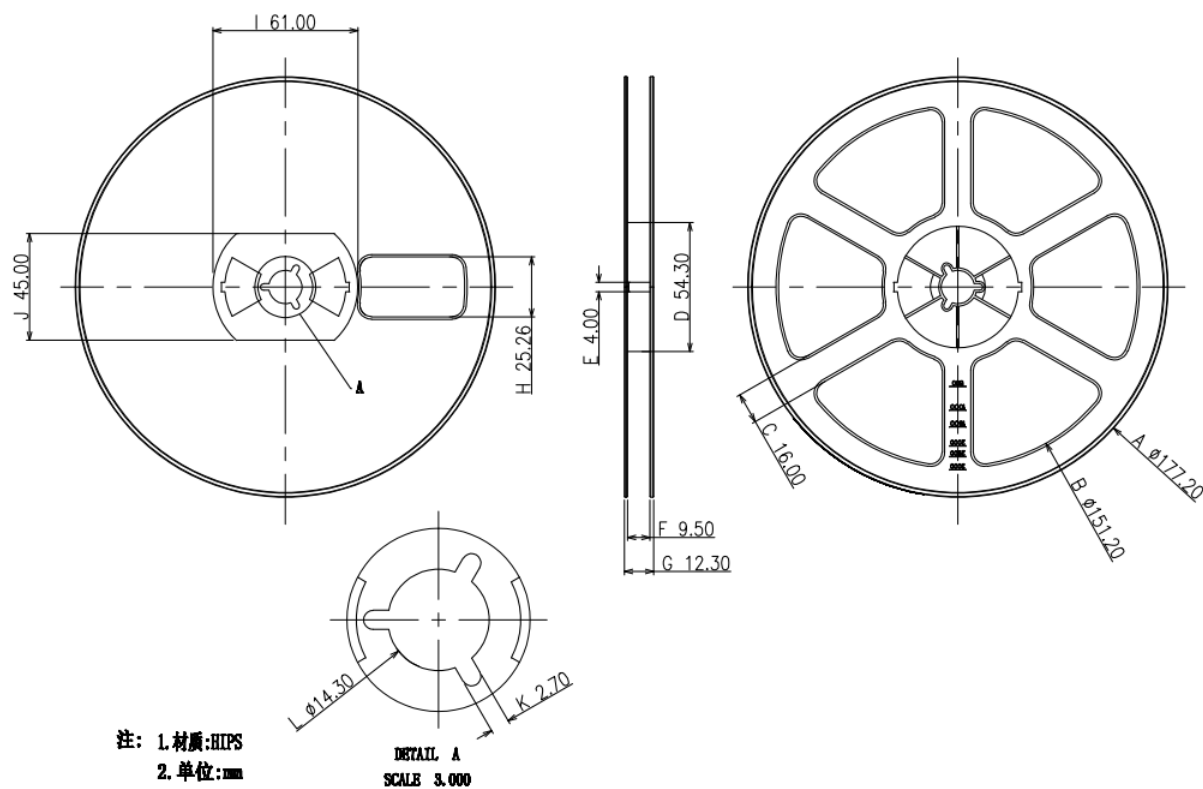
**■ PCB 尺寸推荐**
**DFN1.9×1.6-6L**

**图 14**

- 注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。  
 2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。  
 3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。  
 4.请勿向封装中间的范围扩大焊盘模式。

**■ 载带信息**
**DFN1.9×1.6-6L**

**图 15**

Type	W*P1	Unit
DFN1.9*1.6	8.0*4.0	mm
Item	Specification	Tol ( +/- )
W	8.00	±0.20
F	3.50	±0.05
E	1.75	±0.10
P2	2.00	±0.05
P1	4.00	±0.10
P0	4.00	±0.10
P0*10	40.00	±0.20
D0	1.50	+0.10/-0
D1	1.00	±0.10
T	0.20	±0.02
B0	2.15	±0.10
A0	1.75	±0.10
K0	0.75	±0.10

**表 10**

**■ 卷盘信息**

**图 16**
**■ 包装信息**

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

## 使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。  
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。